

关键指标

通带频率: DC~4GHz
 插入损耗: 1.7dB
 阻带衰减: 24.6dB@5.7GHz, 53.5dB@7.1GHz
 回波损耗: 25dB/25dB
 芯片尺寸: 1.8mm×1mm×0.1mm

产品简介

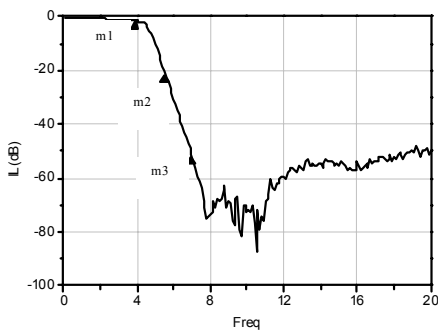
HG124LA 是一款低通滤波器芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 通带频率为 DC~4GHz, 带内插入损耗小于 1.7dB, 带内输入输出回波损耗为 25dB/25dB。

电性能 (T_A=25°C)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~4		
输入回波损耗(dB)	-	25	-
输出回波损耗(dB)	-	25	-
插入损耗(dB)	-	-	1.7
阻带衰减 @5.7GHz(dB)	-	24.6	-
阻带衰减 @7.1GHz(dB)	-	53.5	-

典型测试曲线

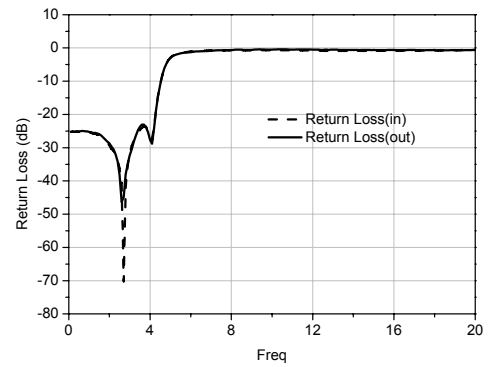
插入损耗



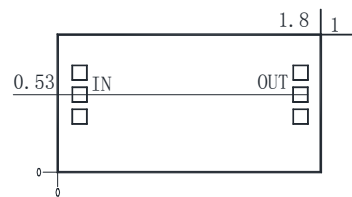
m2
 Freq:5.7GHz
 dB(S(2,1)) = 24.6

m3
 Freq:7.1GHz
 dB(S(2,1)) = 53.5

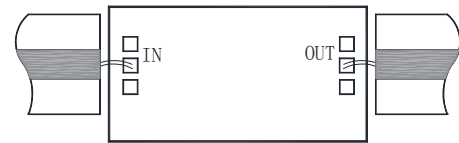
回波损耗



外形和端口尺寸 (mm)



推荐装配图



绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境使用;
2. GaAs 材料较脆, 不能触碰芯片表面, 使用时必须小心;
3. 芯片用导电胶或合金烧结 (合金温度不能超过 300°C, 时间不能超过 30 秒), 使之充分接地;
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 Φ25μm 双金丝键合, 建议金丝长度 250~400μm;
5. 芯片微波端无隔直电容;
6. 芯片对静电敏感, 在储存和使用过程中注意防静电。